

GF 122*

Verwendung: Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor für Verstärker-, Misch- und Oszillatorstufen bei Umgebungstemperaturen ϑ_a von -20°C bis $+65^\circ\text{C}$

Abmessungen: Bauform A 4/15 – 4 b,

TGL 11 811

Masse $\approx 0,6$ g

Zulässige Höchstwerte

für $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}$

$-U_{CB0} = 25$ V

$-U_{EB0} = 0,5$ V

$-U_{CER} = 15$ V

bei $\frac{R_B}{R_E} \leq 50$

mit $R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \leq 100$ k Ω

$I_C = 10$ mA

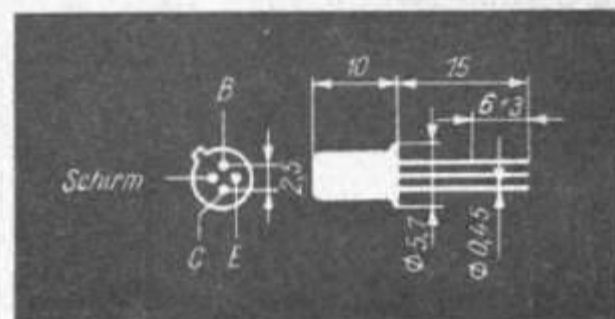
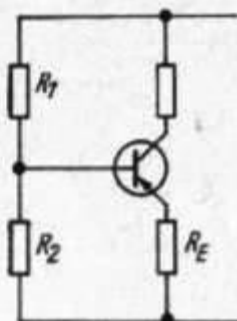
$I_E = 11$ mA

$-I_B = 1$ mA

$P_{tot} = 50$ mW

$\vartheta_j = 75^\circ\text{C}$

$\vartheta_a = 65^\circ\text{C}$



Kennwerte für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5$ grd

Wärmewiderstand $R_{th} \leq 0,6 \frac{\text{grd}}{\text{mW}}$

	Min	Typ	Max	Meßbedingungen
--	-----	-----	-----	----------------

Restströme

$-I_{CBO}$		4 μA	7,5 μA	$-U_{CB} = 6$ V
$-I_{CBO}$			100 μA	$-U_{CB} = 25$ V
$-I_{CES}$			20 μA	$-U_{CE} = 6$ V
$-I_{CER}$		20 μA	90 μA	$-U_{CE} = 6$ V, $R_{BE} = 30$ k Ω
$-I_{EBO}$			100 μA	$-U_{EB} = 0,5$ V

Übergangsfrequenz

f_T	30 MHz	50 MHz		$-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 1$ mA
-------	--------	--------	--	--------------------------------

	Min	Typ	Max	Meßbedingungen
--	-----	-----	-----	----------------

Vierpolwerte in Emitterschaltung

g _{11e}		1,8 mS	2,5 mS	} -U _{CE} = 6 V, -I _c = 1 mA, f = 10 MHz
C _{11e}		105 pF	175 pF	
g _{12e}		33 μS	67 μS	
C _{12e}		4 pF	5 pF	
y _{12e}	28 mS	33 mS	50 μS	
g _{22e}		25 μS	10 pF	
C _{22e}		6 pF		

Gleichstromverstärkung

B	40			-U _{CE} = 6 V, -I _c = 1 mA
---	----	--	--	--

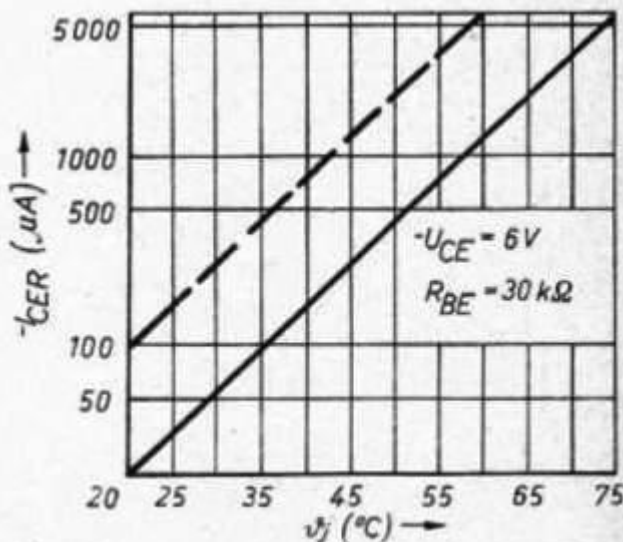
Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 122

* nur für Ersatzbestückung verwenden

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

----- Grenzwert
 ——— Mittelwert



Mittlere Kennlinien für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

